FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS:

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a=25°C)					電気的特性 (T_a=25°C)											外形	備考
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO}最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルスh_{FE} V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	$f_{\alpha b}$ f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* Ω)		
1	2	3	4	5					6		7		8						9	10	11	12

1 TYPE NUMBER

2 ORIGINAL MANUFACTURER

3 USES

4 MATERIAL AND STRUCTURE

5 MAXIMUM RATINGS

6 I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})

7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE} , I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})

8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

9 $f_{\alpha b}$ OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T.

10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)

11 OUTLINE

12 REMARKS

: とコンプリ : COMPLEMENTARY TO ·····

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	$f_{\alpha b}$ f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SA1133	松下	PA	Si.EP	−200	−6	−2A	30W (Tc=25°C)	150	−50	−200	60~200	−10	−400										268	2SC2660 とコンプリ
〃 1134																								
〃 1135	サンケン	PA	Si.EMe	−80	−6	−4A	55W (Tc=25°C)	150	−1mA	−80	90	−4	−1A	−10	200					10*	100	14	324	
〃 1136																								
〃 1137																								
〃 1138	日電	RF.LN	Si.E	−80		−10	500	125	−0.1	−70	400	−6	−1	−6	1	NF=1.5dB (6 V, 1 mA, 1 kHz)				180*	1.4	$C_c r_{bb'}$ 92pS	278	
〃 1139																								
〃 1140																								
〃 1141	日電	PA	Si.T	−115	−5	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−50	−80	140	−2	−1A	−2	1A					90*	390		162	2SC2681 とコンプリ
〃 1142	〃	〃	Si.E	−180	−5	−100	8W (Tc=25°C)	150	−1	−180	200	−5	−10	−10	20					160*	5.8	27*	225	
〃 1143																								
〃 1144	東芝	RF	Si.E	−150	−5	−50	10W (Tc=25°C)	150	−0.1	−150	150	−5	−10	−10	10					200*	2.5	50	342	
〃 1145	〃	〃	〃	−150	−5	−50	800	150	−0.1	−150	160	−5	−10	−10	10					200*	2.5	70*	241	
〃 1146	〃	PA	〃	−140	−5	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−50	−140	120	−5	−1A	−10	1A					70*	220	2*	179	
〃 1147	〃	〃	〃	−180	−5	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−50	−160	120	−5	−1A	−10	1A					60*	350	2*	102	
〃 1148																								
〃 1149																								
〃 1150	東芝	AF	Si.E	−35	−5	−800	300	125	−0.1	−30	100~320	−1	−100	−5	10					120*	19		287	2SC2710 とコンプリ
〃 1151	日電	〃	〃	−60	−5	−100	250	125	0.1	−60	200	−6	−1	−6	10	NF=6dB (−6 V, −0.3mA, f=100Hz)				180*	4.5		138	2SC2718 とコンプリ
〃 1152	〃	RF.SW	〃	−80	−5	−300	600	150	−0.1	−80	200	−1	−50	−6	10	t_{on}=50nS, t_{off}=450nS t_{stg}=400nS				100*	13		138	2SC2719 とコンプリ
〃 1153	〃	〃	〃	−60	−5	500	600	150	−0.1	−40	140	−2	−150	−10	20	t_{on}<35nS, t_{off}<255nS t_{stg}<225nS				400*	5		138D	2SC2720 とコンプリ
〃 1154	〃	〃	〃	−60	−5	−700	1W	150	−0.1	−60	200	−1	−100	−6	10	t_{on}=65nS, t_{off}=540nS t_{stg}=490nS				120*	25		278	2SC2721 とコンプリ
〃 1155	三菱	Diff.	〃	−100	−5	−100	200/unit.	125	−0.1	−100	600	−6	−1	−6	1	h_{FE1}/h_{FE2}=0.8~1.0 ΔV_{BE}<10mV				100*	3		283	
〃 1156																								
〃 1157																								
〃 1158																								
〃 1159																								
〃 1160	東芝	RF	Si.E	−20	−6	−2A	900	150	−10	−20	240	−1	−500	−1	500					150*	60	11	241	
〃 1161																								
〃 1162																								